

Секция «Получение полупроводниковых материалов и их использование»

1-rasm. $\text{Bi}_2\text{Te}_2\text{Se}$ kristall tuzilishi.

Bu o'ziga hoslik Bi_2Te_3 da tartibga solingen birikma hosil bo'lishiga olib keladi, u qotishma paytida xalkogen joyi o'zgaradigan chegara nuqtasi bo'lib xizmat qiladi.

$\text{Bi}_2\text{Te}_2\text{Se}$ kristall tuzilishi olimlarimiz tomonidan juda ko'p o'r ganilgan. Lekin, 300°C ga yaqin haroratlarda faza $x = 0,5$ va $x = 1,4$ ga yaqin birikmalarga ega bo'lган ikkita birikmaga bo'linadi.

n-tipli $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-x}\text{Se}_x$ qotishma tizimini shundan ham murakkab kristall tuzilishga ega ekanligini bilish mumkin.

Adabiyotlar

1. Azimov, T., Gajnazarova, K., & Onarkulov, K. (2020). Method for determining the contact resistance of thermoelements. *Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering*, 2(5), 11.
2. Karimberdi, O., Usmanov, Y., & Toolanboy, A. (2020). Semiconductor sensor for detecting volume changes at low temperatures. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(2), 2353-2358.
3. Onarkulov, K., Gaynazarova, K., & Tashlanova, D. (2022). Termoelektrik samaradorlikni qotishmalardagi elektronlar va teshiklarning harakatchanligiga bog'lanishi. *Science and innovation*, 1(A4), 56-59.
4. Egamberdiyvich, O. K., Yakub, U., & Ma'Rifjonovich, A. T. (2020). Semiconductor sensor for detecting volume changes at low temperatures. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, (1-2), 16-20.
5. Ma'Rifjonovich, A. T., & Egamberdiyvich, O. K. (2020). Effect of commutation solder on the operating characteristics of cooling elements based on bismuth and antimony chalcogenides. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, (1-2), 21-25.
6. Azimov, T. M., Gaynazarova, K. I., Onarkulov, M. K., & Yuldashev, A. A. (2021). Thermoelectric and Galvanomagnetic Properties of the Alloy Bi 2 Te 3 + 0.04 Weight% Ni in the Temperature Range 77÷ 300 K. *American Journal of Modern Physics*, 10(6), 124-128.
7. Gaynazarova Kizlarxon Isroilovna, Mamajonova Sabohat Rustam qizi. STUDY OF STOCHIOMETRICAL COMPOSITION IN OBTAINING TERTIARY COMPOUNDS. Scientific aspects and trends in the field of scientific research International scientific-online conference Part 9 APRIL 30th collections of scientific works Warsaw 2023.
8. G'aynazarova Kizlarxon Isroilovna, Turg'unboyeva Madina Salimjon qizi. PROPERTIES OF ELECTROPHYSICAL PARAMETERS OF SOLID ALLOYS BASED ON Sb-Bi-Te. STUDY OF STOCHIOMETRICAL COMPOSITION IN OBTAINING TERTIARY COMPOUNDS. Scientific aspects and trends in the field of scientific research International scientific-online conference Part 9 APRIL 30th collections of scientific works Warsaw 2023.

**KRISTALLCHALAR O'LCHAMINING TAGLIK HARORATIGA BOG'LIQLIGINI
O'RGANISH**

¹Yuldashev Shohjahon Abrorovich, ¹Yuldasheva Shahrizoda Abrorjon qizi,

²Abduvositov Humoyun Faxriddin o'g'li

¹ Farg'onan davlat universiteti

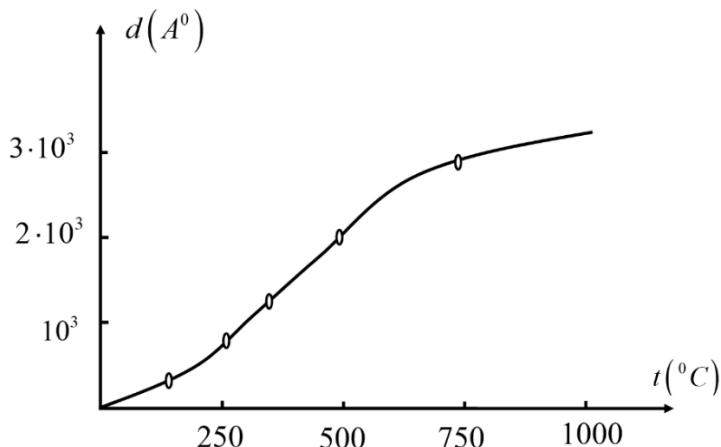
²Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ Фарғона филиали

Секция «Получение полупроводниковых материалов и их использование»

Annotatsiya: Katta uchish tezliklarida, kristalitlar zanjirlaridagi alohida elementar kristallchalar o'lchami kichiklashadi. Uchish tezligi va taglik haroratining aniq bir qiymatlari uchun kristallitlar o'lchami, parda qalinligining o'rtacha qiymatlari bilan bog'liqligi ifodalangan.

Kalit so'zlar: Yupqa parda, anizotrop, xalkogenid, harorat, tezlik, bir jinsli bo'lмаган.

Yupqa pardalar tuzilishi bir jinsli bo'lмаган sohalarning shakllanishi asosan birikma va yot aralashmalar atom va molekulalarning uchuvchanligining xilma-xilligi bilan bog'liq ekan [1]. Har xil uchuvchanlik va eruvchanlikka ega bo'lgan elementlardan tashkil topgan yarimo'tkazgich xalkogenid birikmalarini. Termik anizotrop bug'latish tufayli vujudga kelgan molekulyar oqimga bog'liq fizik jarayonlarni magnit va elektr maydonlari orqali boshqarib, yupqa pardada vujudga keladigan bir jinsli bo'lмаганларни miqdoran va sifat jixatlaridan o'zgartirishi mumkin. Masalan, klasterlarning o'lchami va tabiatiga ta'sir etish mumkin. Bu esa o'z navbatida yupqa pardalarda kuzatiladigan anomal fotoelektrik va fotomagnit hodisalar bilan bog'liqligi tabiiydir. Ma'lumki, uchuvchanlik yupqa pardalar olishda anizotropik bug'latish tufayli vujudga kelgan ko'ndalang bir jinsli bo'lмаган sohalari bilan bog'liq bo'lsa, eruvchanlik yupqa parda bilan taglikni bog'lovchi sirtlarning mustaxkam bog'lanishini (adgeziya) ta'minlovchi fizik jarayonlar bilan bog'liq. Tashqi elektr va magnit maydonlari ta'sirida bo'ylama sirt, bir jinsli bo'lмаган sohalariga ta'sir etib, bir jinsli bo'lмаган sohalarining o'ta ko'p sondagi ketma-ket zanjirining shakllanishidagi fizik jarayonlarga ta'sir etishi mumkin. Katta uchish tezliklarida, kristalitlar zanjirlaridagi alohida elementar kristallchalar o'lchami kichiklashadi. Uchish tezligi va taglik haroratining aniq bir qiymatlari uchun kristallitlar o'lchami, parda qalinligining o'rtacha qiymatlari bilan bog'liq. Kristallchalar o'lchamining taglik harorati bilan bog'liqligining, taglik (xalkogenid binar birikmalar A^{II}B^{VI} tiplari uchun) qonuniyati ifodalangan (1-rasm).



1-Rasmdagi kristallchalarning chiziqli o'lchami A° angstromda, taglik harorati °C da, berilgan.

Kristallchalarning chiziqli o'lchamlarining o'rtacha qiymati, xalkogenid pardaning temperaturaviy ishlov berish sharoitiga ham bog'liq vakuum, qizdirish davomiyligi va haroratga.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- Onarkulov, M., Nasriddinov, S., Yuldashev, S., & Yunusaliev, L. (2020). TECHNOLOGICAL FEATURES OF OBTAINING STRENGTH SENSITIVE POLYCRYSTALLINE FILMS Bi₂-X₂Sb_XTe₃. Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering, 2(3), 27.

Секция «Получение полупроводниковых материалов и их использование»

2. Onarkulov, K. E., Naymanbayev, R., Yuldashev, A. A., & Yuldashev Sh, A. (2021). Халкогенид бирикмалари устида тадқиқотлар. Eurasian journal of academic research, 1(6), 136-137.
3. Онаркулов, К. Э., Юлдашев, Ш. А., & Юлдашев, А. А. (2022). ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЙ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(3), 427-434.
4. Onarkulov, K. E., Naymonboyev, R., Yuldashev Sh, A., & Yuldashev, A. A. (2021). Preparation of photo elements from chalcogenide thin curtains. *Electronic journal of actual problems of modern science, education and training*, 7(2).
5. Egamberdievich, O. K., Abrorovich, Y. S., Abduvositovich, Y. A., & Qizi, Y. S. A. (2022). Determination of Microparameters of Halcogenide Thin Movies. *Journal of Optoelectronics Laser*, 41(5), 523-530.
6. Онаркулов, К., & Юлдашев, А. (2017). ВИСМУТ-СУРМА ТЕЛЛУРИД ЮПҚА ПАРДАЛАРНИНГ ЭЛЕКТРОФИЗИК ХОССАЛАРИГА ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁННИНГ ТАЪСИРИ. *Scientific journal of the Fergana State University*, (2), 2-2.
7. Yuldashev, A. (2022). ОПТОТРАНСФОРМАТОР. Science and innovation, 1(A7), 876-882

BI-SB QOTISHMALARIDA HOLL EFFEKTI VA HARAKARCHANLIK
Q.G'aynazarova, E.Xamdamova, S.Karimov

Farg'onan davlat universiteti

Annotatsiya: Vismutning surma va tellur bilan qotishmalariga turli darajada donor va akseptor aralashmalari (Te, Sn) xalkogenid sifatida kiritilganda asosning harorat diapazoni keng qamrovli o'rGANildi.

Vismutning surma va tellur bilan qotishmalarining elektrofizik xususiyatlariga ta'sir qilishning eng ko'p qo'llaniladigan usullaridan biri asosga ortiqcha miqdor elementlarni legirlash bo'lib, bu, bir tomonidan, ushbu materiallarning tarmoqli tuzilishini energetic zona kengligini o'rGANishga imkon beradi.

Vismutning surma va tellur bilan qotishmalari yarim metallar va tor yarimo'tkazgichlar sinfining eng tipik vakillari hisoblanadi. Ushbu materiallarni o'rGANishga nazariy va amaliy qiziqish ularning zaryad tashuvchilarning energetik soha kengligining o'ziga xos fizik xususiyatlarini ochib berdi. Surma konsentratsiyasining oshishi bilan $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$ qotishmalari yarimmetall ($0 < x < 0,07$) holatdan yarimo'tkazgich ($0,07 < x < 0,22$) holatiga, so'ngra yana yarim metall ($0,22 < x < 1$) holatga o'tadi.

Harorat T pastligi va kontsentratsiya r miqdori kattaligi natijasida zaryad tashuvchilarning aynigan holatida, harorat ortishi bilan "yengil" kovaklarning bir qismi holatlar zichligining effektiv massasi kattaroq va harakatchanlik kamroq zaryad tashuvchilar aynimagan holatiga ega bo'lgan ikkinchi tagzonaga-og`ir kovaklar zonasiga o'tadi. Shuningdek, asosning valent zonasi tuzilishi noodatiy xarakterga egaligini Xoll koeffitsiyenti va harakatchanligining temperaturaviy bog`lanishlari ham tasdiqlaydi (1a- va b-rasmlar). Xoll koeffitsiyenti uchun sferik zonalar va teshiklar sochilish mexanizmi bir xil deb olinganda

$$R_x = \frac{r}{e} \frac{p_1 \mu_1^2 + p_2 \mu_2^2}{(p_1 \mu_1 + p_2 \mu_2)^2}, \quad (1)$$